

What Is Claimed Is:

1. 多数の含硫黄分子が固定化可能なように、金メッキ体の表面に、温度 350～790℃でアニール化処理を施す、金メッキ体の表面処理法。
2. 表面金結晶が(1, 1, 1)面の配向面を30%以上有する構造になるように処理する、請求項1記載の金メッキ体の表面処理法。
3. 前記金メッキ体は、導電性基材を金メッキ溶液に浸漬し、該導電性基材及び該金メッキ溶液に電流を流して得られた電気メッキ体である請求項1又は2記載の金メッキ体の表面処理法。
4. 前記金メッキ溶液に、結晶成長剤を添加する請求項3記載の金メッキ体の表面処理法。
5. 前記含硫黄分子が、核酸残基、蛋白質残基又は蛋白質結合性基を含む請求項1又は2の何れかに記載の金メッキ体の表面処理法。
6. 前記含硫黄分子が、塩基配列が未確認の遺伝子を検出するためのプローブである請求項1又は2記載の金メッキ体の表面処理法。
7. 請求項1又は2記載の表面処理法により処理された金メッキ体の表面処理物。
8. 表面金結晶が(1, 1, 1)面の配向面を30%以上有する構造である請求項7記載の表面処理物。
9. 請求項1又は2記載の表面処理法により処理した金メッキ体の表面処理物に、多数の含硫黄分子を固定化する、含硫黄分子の固定化法。
10. 表面に多数の含硫黄分子が固定化可能な金メッキ体を製造する方法であって、結晶成長剤を含む原料から表面金結晶を形成する金メッキ体の製造方法。
11. 金メッキ溶液に結晶成長剤を添加し、そこへ導電性基材を浸漬し、該導電性基材及び結晶成長剤を添加した該金メッキ溶液に電流を流して金メッキ体を得る、請求項11記載の金メッキ体の製造方法。
12. 表面金結晶が(1, 1, 1)面の配向面を30%以上有する構造になるように形成する、請求項10又は11記載の金メッキ体の製造方法。
13. 前記含硫黄分子が、核酸残基、蛋白質残基又は蛋白質結合性基を含む請

求項 1 0 又は 1 1 記載の金メッキ体の製造方法。

1 4. 前記含硫黄分子が、塩基配列が未確認の遺伝子を検出するためのプローブである請求項 1 0 又は 1 1 記載の金メッキ体の製造方法。

1 5. 請求項 1 0 又は 1 1 記載の製造方法により得られる金メッキ体。

1 6. 表面金結晶が (1, 1, 1) 面の配向面を 3 0 % 以上有する構造である請求項 1 5 記載の金メッキ体。

1 7. 請求項 1 0 又は 1 1 記載の製造方法により得られた金メッキ体に、多数の含硫黄分子を固定化する、含硫黄分子の固定化法。

10067502 020702
202502 202502